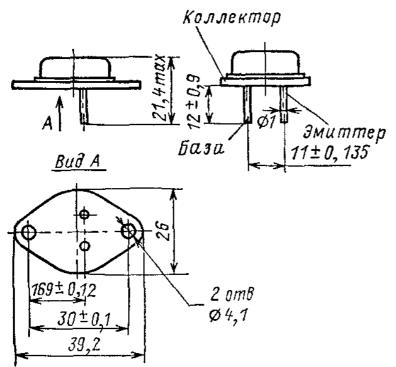
Силовые транзисторы типов ТК135-16, ТК135-25

Транзисторы силовые кремниевые эпитаксиально-мезапланарные (ТУ 16-729.911-81, ТУ 16-729.308-81) предназначены для применения в преобразователях, переключающих и усилительных устройствах, в схемах управления электроприводом и т. д.



Транзисторы выпускаются в фланцевом конструктивном исполнении. Масса не более 17,6 г.

Транзисторы допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от -60 до $+40^{\circ}\mathrm{C}$, атмосферном давлении 0.085-0.105 МПа, относительной влажности 98% при 35 °C.

Климатические исполнения и категория размещения У2, УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

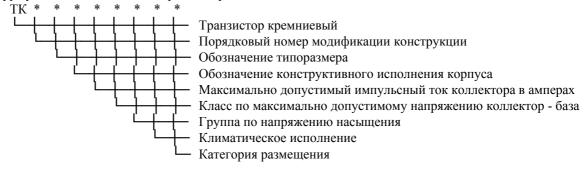
Транзисторы предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях, исключающих воздействие ионизирующих излучений (нейтронного, электронного, у-излучения и т. д.).

Транзисторы допускают воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот $1 - 100 \, \Gamma$ ц с ускорением 49 м/с 2 и ударных нагрузок с ускорением до $147 \, \text{m/c}^2$.

Монтаж транзисторов производится

прижатием фланца корпуса к теплоотводу с моментом затяжки винтов не менее 0,4±0,05 Н*м.

Структура условного обозначения транзистора.



Электрические параметры Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $(\text{Тпер} = 25^{\circ}\text{C}, \text{ Iк} = 0.5 \text{ Iк макс}, \text{ Uк} = 5 \text{ B}, \text{ tp} = 100...300 \text{ мкс}, \text{ скважность не менее 50})$ классы 0,5...2 8...100 классы 2,5...6 10...100 Напряжение насыщения коллектор — эмиттер ($I\kappa = 0.5$ $I\kappa$ макс, $I\delta = 0.08$ $I\kappa$ макс, Tnep = 25 °C) для группы 1 (классы 0,5...2) 0.6 Bдля группы 2 (классы 0,5...6) 1,5 B для группы 3 (классы 0,5...6) 2,0 B Обратный ток эмиттер — база (Тпер = 150°C, Uэб = 4 В) 150 мА Обратный ток коллектор — база (Тпер = 150°C, І $_{2}$ = 0) 10 mA Время включения (Tnep = 25°C, Iк = Iк макс, Iб = 0.08Iк макс) 1,0 мкс в том числе время задержки 0,3 мкс время нарастания 0,7 мкс Время выключения (Tnep = 25° C, Iк = Iк макс, Iб = 0.08Iк макс) 3 мкс в том числе

```
время рассасывания
                                                                               2 мкс
                    время спада
                                                                               1 мкс
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ
                                                                               2 МГц
Тепловое сопротивление переход — корпус Вероятность безотказной работы за 1000 ч
                                                                               1,5 °C/B<sub>T</sub>
                                                                               0,97
```

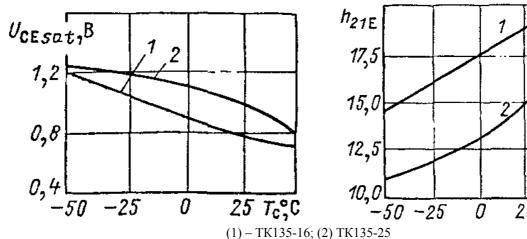
Предельно допустимые значения параметр	оов транзисторов		
Максимально допустимый импульсный ток коллектора (tp < 10 мс, сквах	жность 2, $Iб = 0.20 Iк - для классов 0.52$,		
$I6 = 0.25 I \kappa$ - для классов 2.56)			
TK135-16 16 A			
TK135-25 25 A			
Максимально допустимый импульсный ток базы (tp < 10 мс, скважность 2)			
TK135-16 4 A			
TK135-25 7 A			
Максимально допустимый постоянный ток коллектора			
TK135-16 10 A			
TK135-25 16 A			
Максимально допустимый постоянный ток базы			
TK135-16 3,5 A			
TK135-25 5 A			
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база 50600 В			
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер	30360 B		
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер 45540 В			
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор – эмиттер 45540 B			
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база			
для классов 0,52 4 B			
для классов 2,56 6 В			
Рассеиваемая мощность коллектора 80 Вт			
Температура перехода -60+			
Температура хранения -60+	50°C		

По максимально допустимому импульсному напряжению коллектор-база транзисторы делятся на восемь классов, а по напряжению насыщения коллектор — эмиттер — на три группы.

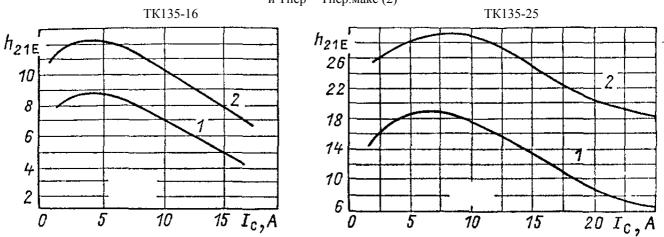
Максимально допустимое		
Класс	импульсное напряжение	
	коллектор — база, В	
0,5	50	
1,0	100	
1,5	150	
2,0	200	
2,5	250	
3,0	300	
3,5	350	
4,0	400	
5,0	500	
6,0	600	
7,0	700	
8,0	800	

Группа по напряжению	Значение напряжения
насыщения	насыщения, В
коллектор — эмиттер	
1	До 0,6
2	Св. 0,6 до 1
3	Св. 1 до 1,5

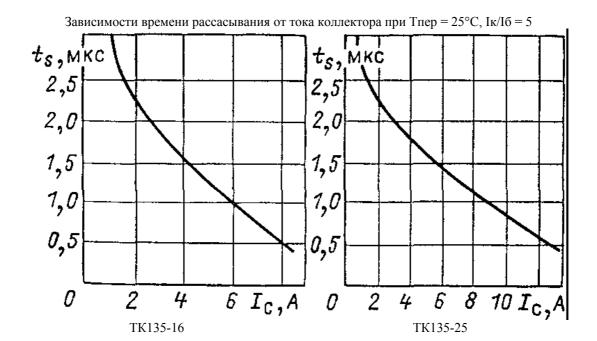
Зависимость напряжения насыщения коллектор - эмиттер от температуры корпуса на постоянном токе зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса на постоянном токе

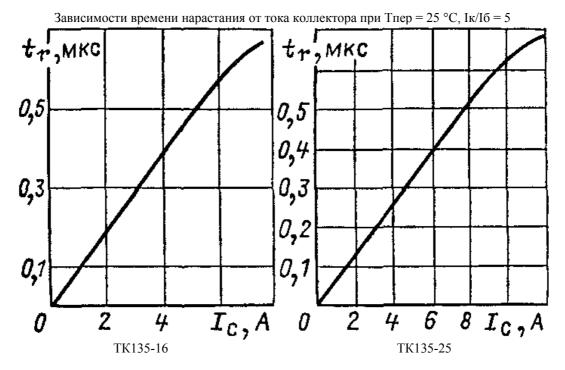


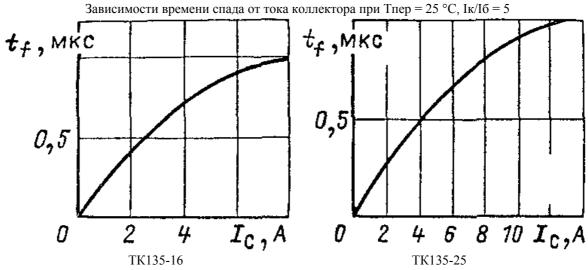
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора при Uкэ = 5 B, Tпер = 25°C (1) и Tпер = Tпер.макс (2)



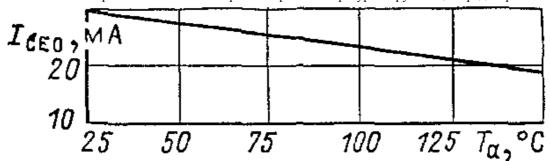
Зависимости обратного тока коллектор-эмиттер Зависимости рассеиваемой мощности от температуры корпуса при Іб = 0 от температуры корпуса P_{CM}, BT I_{CEO} , MA 50 40 30 10 20 10 25 Tc,°C 40 60 80 100 Tc,°C 0 (1) - TK135-16; (2) TK135-25



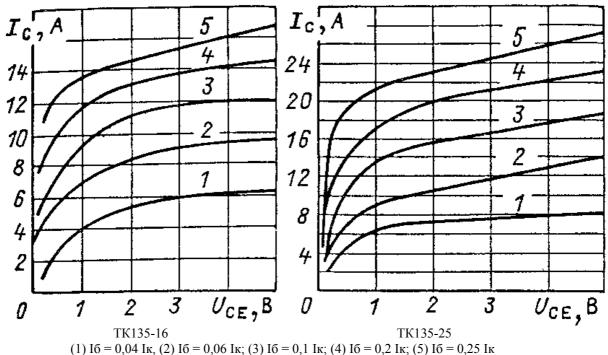


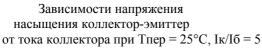


Типовая зависимость обратного тока коллектор-эмиттер от температуры окружающей среды при Rб <3,4 Ом

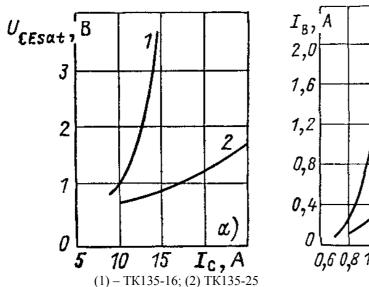


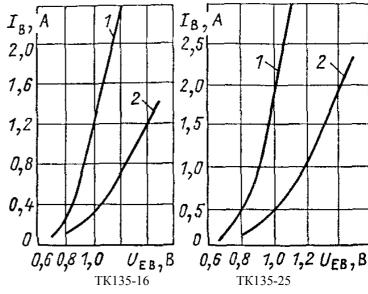
Выходные характеристики в импульсном режиме при Tnep = 25°C





Входные характеристики при Uкэ = 0 (1);Uкэ = 2 B (2)





Типовая область изменения напряжения коллектор-эмиттер в зависимости от сопротивления в цепи база-эмиттер при $Tnep=150^{\circ}C$

